



Микросхема ИСМЦ164

Э Т И К В Т К А

Полупроводниковая интегральная микросхема ИСМЦ164

"Восьмиканальный мультиплексор"

Основное назначение: восьмиканальный мультиплексор.

Схема расположения выводов

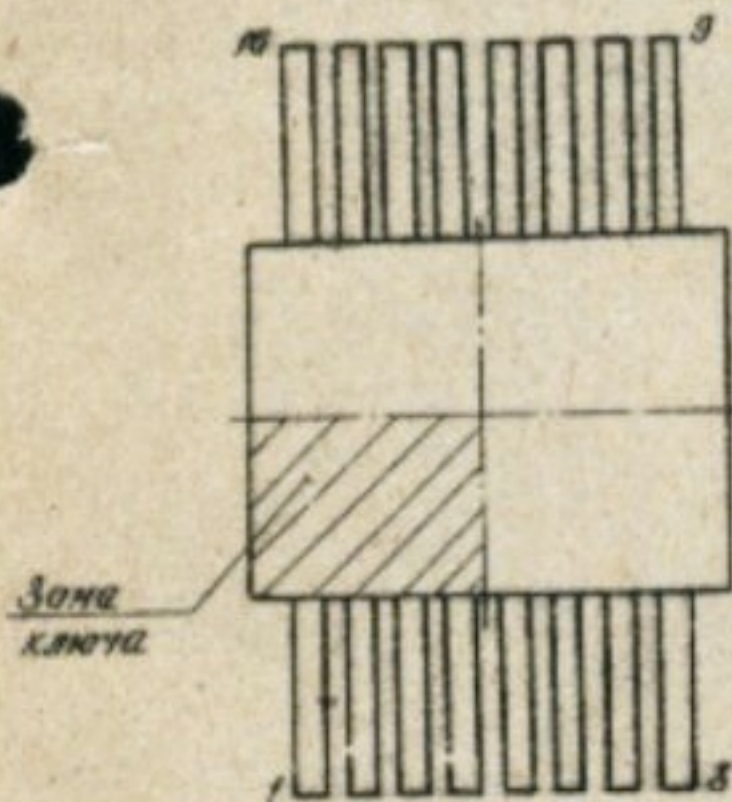
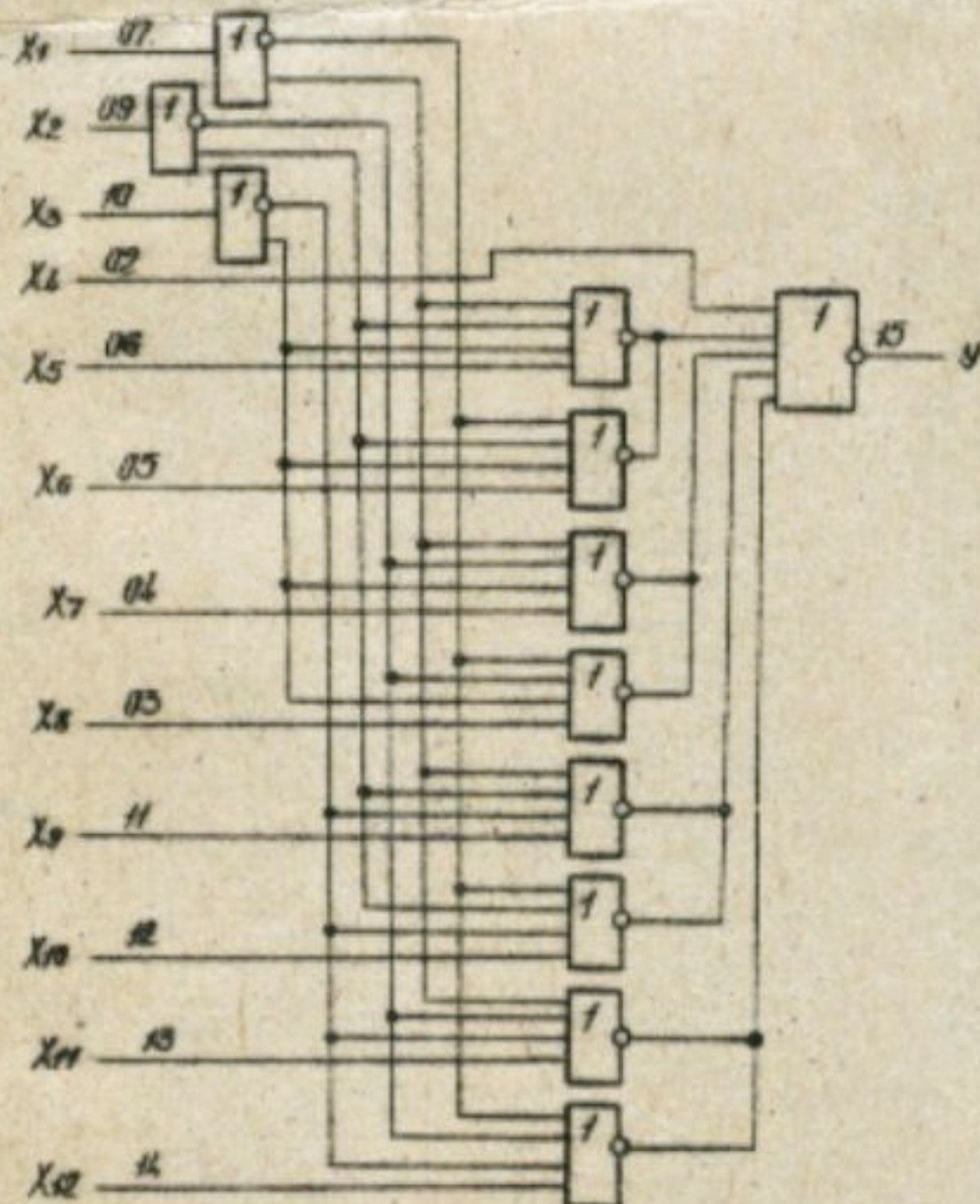


Схема электрическая функциональная



Контакт	Цепь
1	Общий
2	Вход X <sub>4</sub>
15	Выход Y
8	Питание
7	Вход X <sub>1</sub>
9	Вход X <sub>2</sub>
10	Вход X <sub>3</sub>
3	Вход X <sub>8</sub>
4	Вход X <sub>7</sub>
5	Вход X <sub>6</sub>
6	Вход X <sub>5</sub>
14	Вход X <sub>12</sub>
13	Вход X <sub>11</sub>
12	Вход X <sub>10</sub>
11	Вход X <sub>9</sub>
16	Общий

ОСНОВНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ ПРИ ПОСТАВКЕ

Наименование параметра	Н о р м а	
	не менее	не более
Выходное пороговое напряжение логической единицы, $U^{*}_{вых,пор}$ , В $U_{и.п.} = -5,2$ В, $U^{*}_{вх,пор} = -1,105$ В, $U^{*}_{вх,пор} = -1,475$ В, $U_{сч} = -2$ В, $R_H = 51$ Ом	-0,980	
Выходное пороговое напряжение логического нуля, $U^{*}_{вых,пор}$ , В $U_{и.п.} = -5,2$ В, $U^{*}_{вх,пор} = -1,105$ В, $U^{*}_{вх,пор} = -1,475$ В, $U_{сч} = -2$ В, $R_H = 51$ Ом		-1,630
Входной ток логического нуля, $I^{*}_{вх}$ , мА $U_{и.п.} = -5,2$ В, $U^{*}_{вх} = -1,850$ В, $U_{сч} = -2$ В, $R_H = 51$ Ом	0,0005	
Время задержки распространения при включении, $t^{*}_{за.р}$ , нс $U_{и.п.} = -3,2$ В, $U_{и.п.2} = 2,0$ В, $U^{*}_{вх} = 1,110$ В, $R_H = 51$ Ом, $Z_B = 50$ Ом		8
Время задержки распространения при выключении, $t^{*}_{за.р}$ , нс $U_{и.п.} = -3,2$ В, $U_{и.п.2} = 2,0$ В, $U^{*}_{вх} = 1,110$ В, $R_H = 51$ Ом, $Z_B = 50$ Ом		8
Коэффициент разветвления по выходу, К раз		10
Номинальное напряжение источника питания $U_{и.п.} = -5,2$ В		

ПРЕДЕЛЬНЫЕ ЗНАЧЕНИЯ ДОПУСТИМЫХ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ РЕЖИМОВ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Наименование параметра	Н о р м а		Примечание
	не менее	не более	
Напряжение питания, $U_{и.п.}$ , В	-7 -6		в течение 5 мс постоянно
Максимальное входное напряжение, $U_{вх,мах}$ , В		0	
Минимальное входное напряжение, $U_{вх,мип}$ , В	-5,5		
Максимальный выходной ток, $I_{вых,мах}$ , мА		40	
Предельно-допустимая температура кристалла, Т кр, °С		125	

Содержание драгоценных металлов (на 1000 шт.)

Место для штампа

" золото " 30,0203 г  
" серебро " 25,1628 г

УКАЗАНИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Указания и рекомендации по эксплуатации в соответствии с разделом 5 ОТУ ОСТ В II.073.041-75 и ОСТ II.073.040-75 "Микросхемы интегральные. Руководство по применению".

Запрещается подавание каких-либо электрических сигналов /в том числе ште "питание" и "земля"/ к корпусу и к выводам микросхем, неиспользуемым согласно электрической принципиальной схеме микросхемы.

При ремонте аппаратуры и измерении параметров микросхемы в контактирующих устройствах, замену микросхем необходимо производить только при отключенных источниках питания.

При измерении параметров микросхем, испытаниях под электрической нагрузкой и эксплуатации в аппаратуре следует учитывать, что корпус микросхем находится под потенциалом, равным напряжению питания.

При эксплуатации допускается объединение микросхем по выходам, при этом величина помехоустойчивости уменьшается и не регламентируется.

При работе с микросхемами должны быть приняты меры по защите от воздействия электростатического заряда. Предельное значение электростатического потенциала 30 В /в соответствии с ОСТ II 240.336.013-73/.

Микросхема 100Ш164 соответствует техническим условиям 3.088.088 ТУ и признана годной для эксплуатации.

Дата выпуска  
Место для штампа  
ОТК

ОТК  
164

Место для штампа  
представителя заказчика

79

29 Aug 1978